

# Schema del processo di fabbricazione

*Maurizio Boscardin*  
*boscardi@fbk.eu*



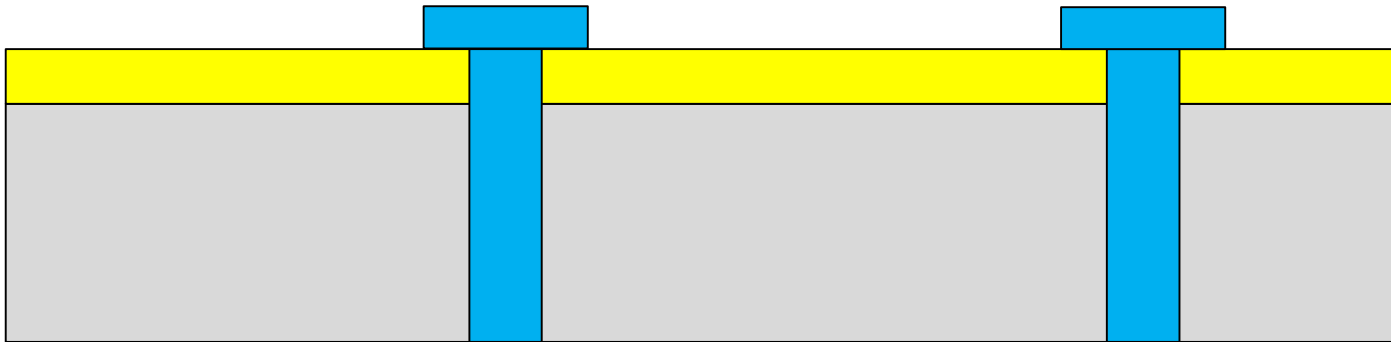
**Fondazione Bruno Kessler**  
**Centre for Materials and Microsystems**



Ossidazione  
p-spray  
TEOS



Litho fori ohmici  
DRIE



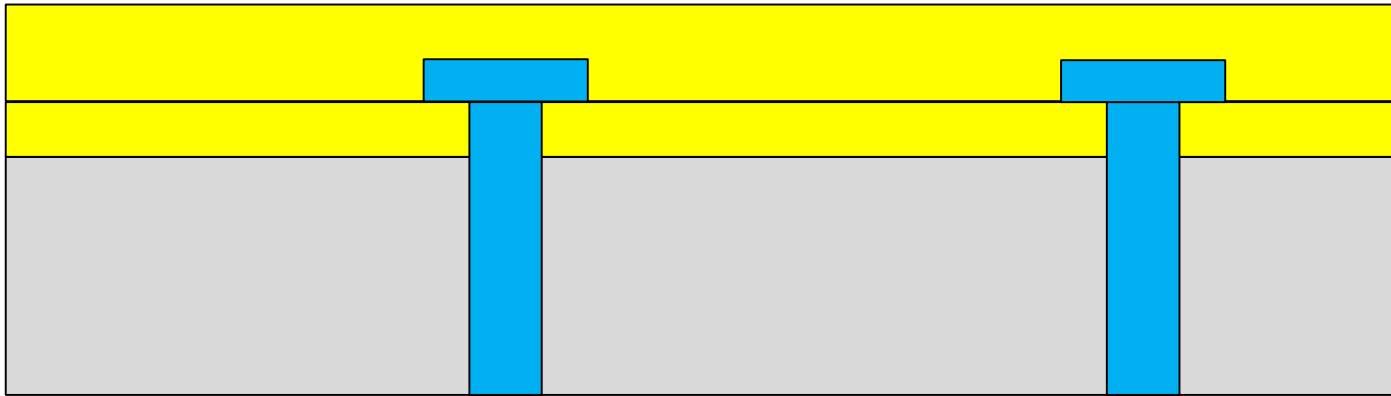
Poly deposizione (riempimento)

Doping

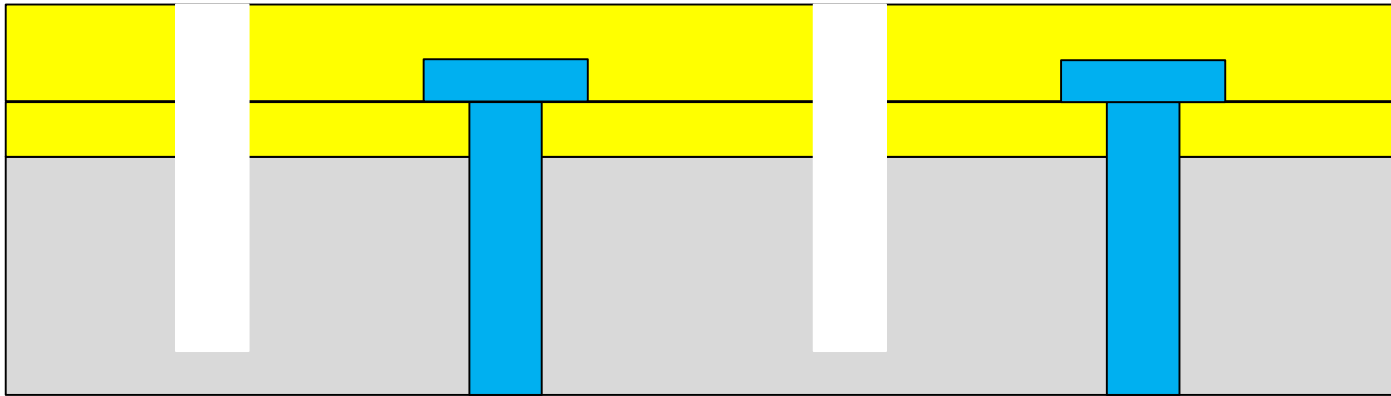
Litho p+

Dry etch

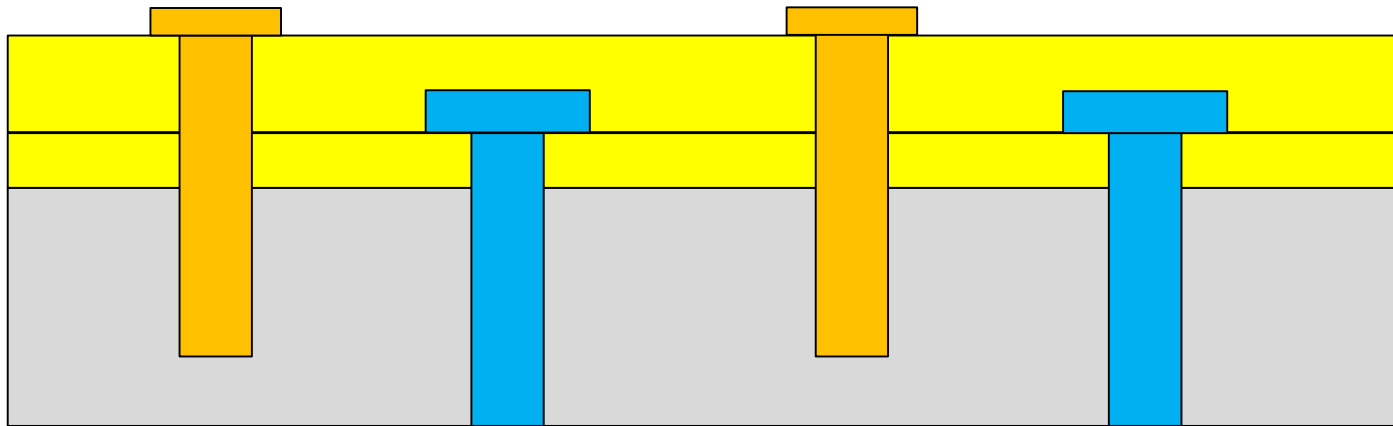
*non fare la definizione del poly ma solo «pulire» la superficie del silicio*



Deposizione TEOS



Litho fori giunzione  
DRIE

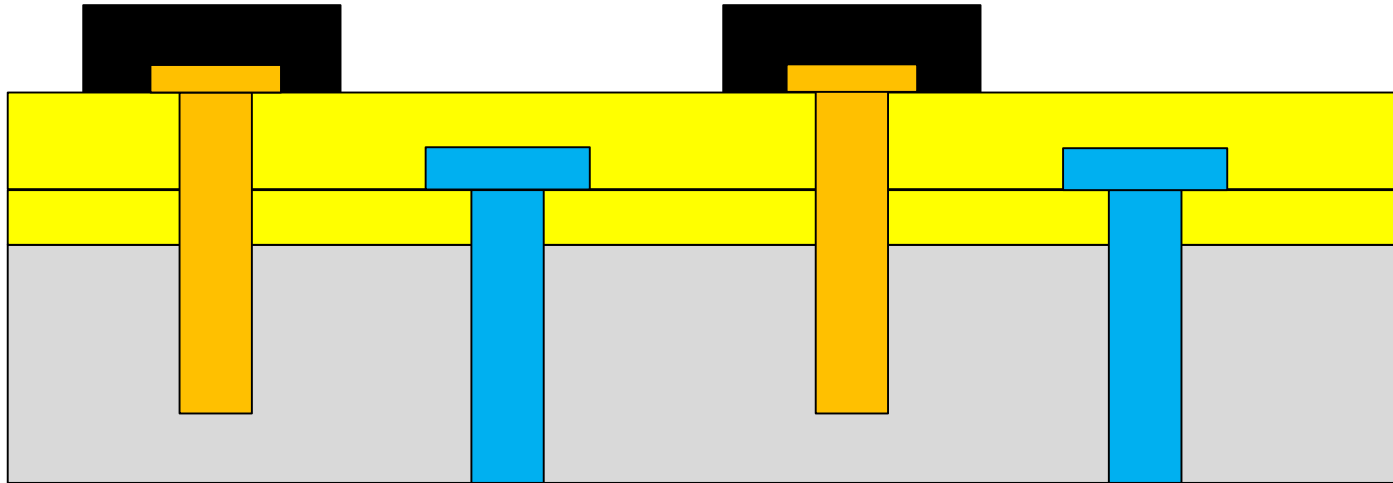


Poly riempimento parziale

Doping

Litho n+

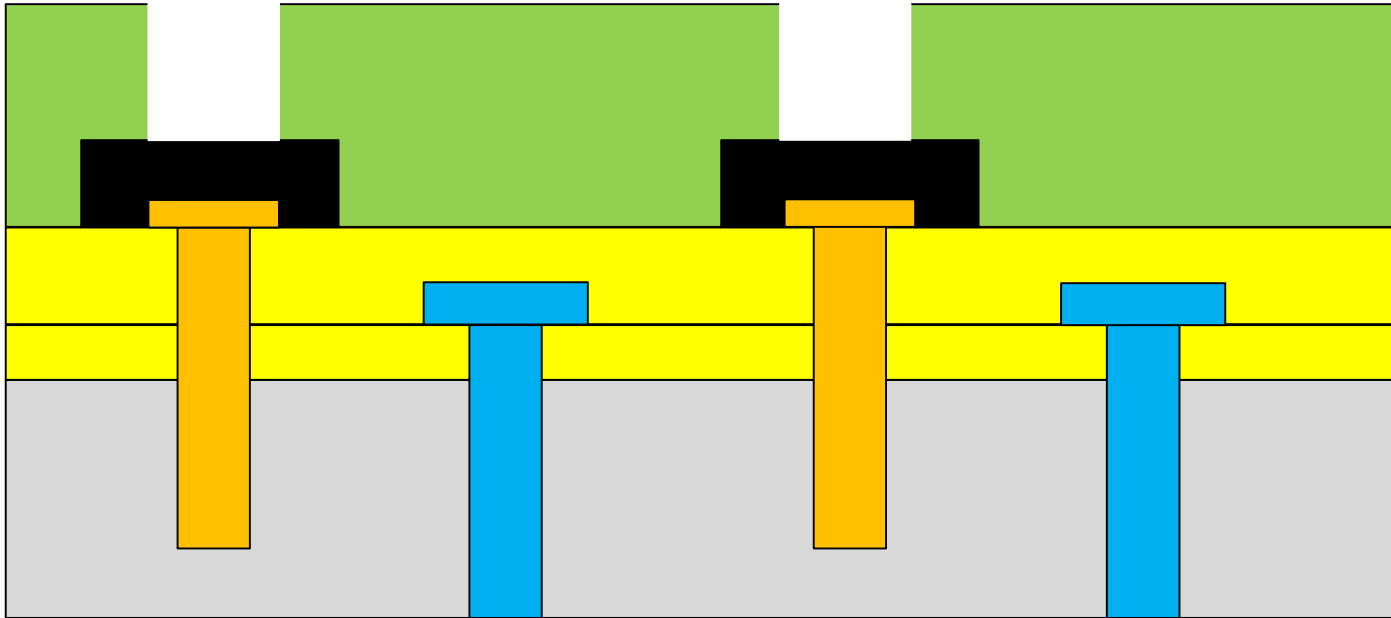
Dry etch



Deposizione e definizione metallo

*serve prevedere un'altra deposizione di ossido + litho per l'apertura contatti ?*





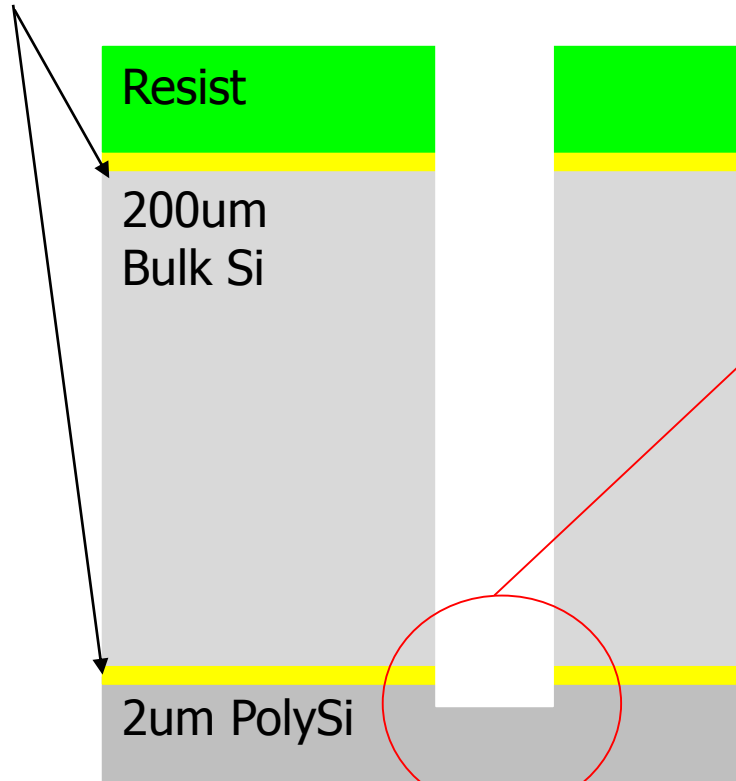
Deposizione e definizione passivazione



# Controls of the hole depth 3/3

## Ohmic columns on SOI: SiO<sub>2</sub> etching

200nm SiO<sub>2</sub>



200nm SiO<sub>2</sub>

